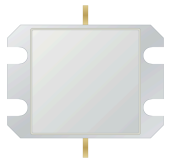
ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 51 dBm (نموذجي) 8500–9600 MHz GaN



LCT-8500-9600-PS51T · 8500–9600 MHz · GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية.

قيم جدول الخصائص RF: PSAT 51 dBm (نموذجي)؛ كسب القدرة 9 dB (نموذجي)؛ PAE 38 % (نموذجي). شروط قياس RF: Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm.

CMW025B

طبّق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف، وعند الإيقاف أزل انحياز المصرف أولاً.

Vg: C = 10 µF

خصائص RF

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	8500	-	9600	MHz
قدرة الخرج المشبعة	-	50	51	-	dBm
كسب القدرة	-	8	9	-	dB
كفاءة القدرة المضافة	-	-	38	-	%
استواء كسب القدرة	-	-	-	±0.8	dB

انحياز DC والتيارات

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
جهد تشغيل المصرف	-	-	-	-	28	V
جهد تشغيل البوابة	-	-	-	-	-3	V

القيم الحدية

قيم حدية وليست نقاط ضبط للتشغيل العادي.

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد بين المصرف والمصدر	-	-	-	32	V
أدنى انحياز للبوابة	-	-5	-	-	V
درجة حرارة التخزين	-	-65	-	150	°C
أقصى قدرة دخل	-	-	-	45	dBm
أقصى درجة حرارة للقناة	-	-	-	200	°C

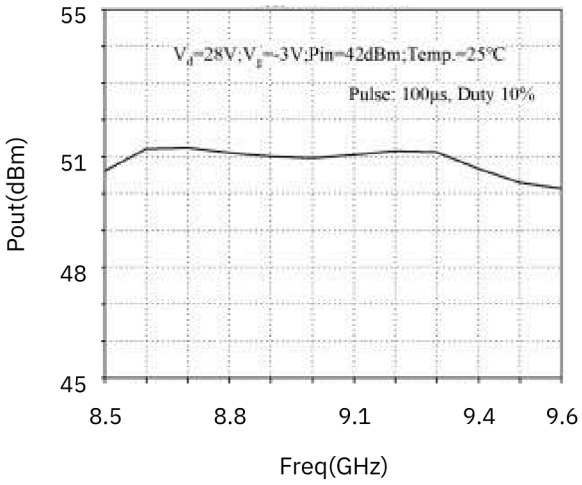
سجل الإصدار الحالي · 1.5 · 2026-11-12. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.4.

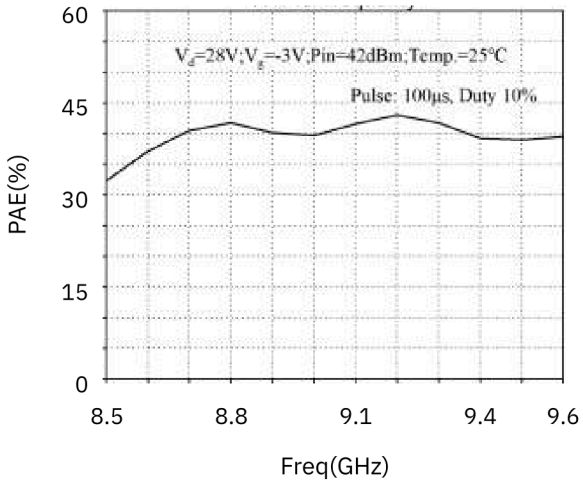
ملاحظات الدمج

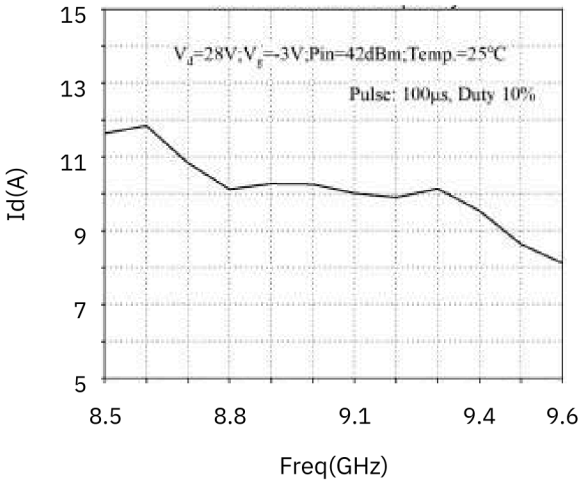
CMW025B طبّق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف، وعند الإيقاف أزل انحياز المصرف أولاً. Vg: C = 10 µF G: دخل RF D: خرج RF S: المصدر / الأرضي

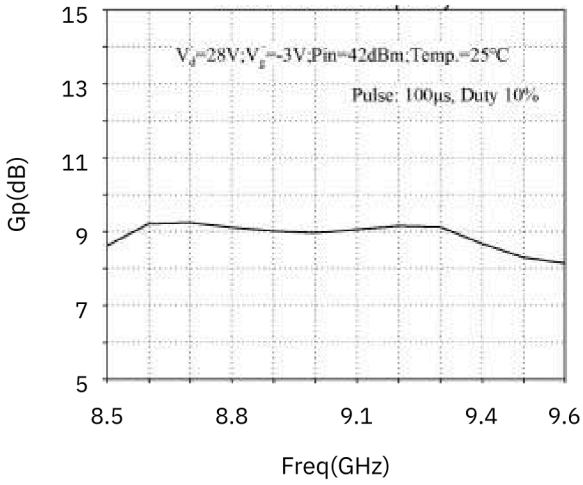
منحنيات الأداء

تُقرأ كل صورة مع مراعاة ظروف التشغيل المحددة لها.









قدرة الخرج؛ كفاءة القدرة المضافة؛ تيار المصرف؛ كسب القدرة. Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 42 dBm; TA = 25 °C; PW = 100 µs; D = 10%.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.